



Toshiba introduce MOSFET di potenza a canale N da 100V per applicazioni industriali

I nuovi dispositivi in tecnologia U-MOS IX-H offrono i valori di resistenza più bassi della propria categoria

Düsseldorf, Germania, 07 Febbraio 2018 – Toshiba Electronics Europe ha iniziato a consegnare due nuove aggiunte da 100V alla propria serie di MOSFET a bassa potenza IX-H U-MOS a canale N. I nuovi dispositivi sono ideali per l'alimentazione degli impianti industriali, nonché per le applicazioni di controllo dei motori.

Fabbricati nell'ultimo processo U-MOS IX-H trench a bassa tensione di Toshiba, che ottimizza la struttura degli elementi, il TPH3R70APL e il TPN1200APL forniscono i valori più bassi di resistenza della propria categoria, rispettivamente pari a 3,7mΩ e a 11,5mΩ. I dispositivi presentano una carica in uscita bassa (Q_{oss} : 74 / 24nC) e una carica di commutazione di gate ridotta (Q_{sw} : 21 / 7,5nC) e permettono di ottenere un livello logico di pilotaggio di 4,5V.

Rispetto agli attuali dispositivi che sono basati sul processo U-MOS VIII-H, i nuovi dispositivi presentano valori inferiori delle principali figure di merito dei MOSFET per applicazioni di commutazione, tra cui $R_{DS(on)}Q_{oss}$ e $R_{DS(on)}Q_{sw}$.

Il TPH3R70APL è alloggiato in un package SOP Advance da 5mm x 6mm e può gestire correnti di drain (I_D) fino a 90A, mentre il TPN1200APL è disponibile in un package TSON Advance da 3mm x 3mm e gestisce livelli di I_D fino a 40A.

Toshiba Electronics Europe continuerà a espandere il proprio portafoglio di MOSFET in linea con le tendenze del mercato, per continuare a migliorare l'efficienza nell'alimentazione.

###

Informazioni su Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) è la divisione Europea dedicata alla produzione di componenti elettronici di [Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation](#). TEE offre ai consumatori e alle aziende Europee un'ampia varietà di unità a disco rigido (HDD), oltre a soluzioni su semiconduttore per applicazioni automotive, industriali, IoT, per il controllo del movimento, telecom, di rete, consumer e per gli elettrodomestici. Il vasto portafoglio di prodotti della società comprende IC wireless integrati, semiconduttori di potenza, microcontrollori, semiconduttori ottici, ASIC, ASSP e dispositivi discreti che vanno dai diodi agli IC logici.

Fondata nel 1973 a Neuss in Germania, TEE ha sede principale a Düsseldorf in Germania, con filiali in Germania, Francia, Italia, Spagna, Svezia e nel Regno Unito con attività di progettazione, produzione, marketing e vendite. Il presidente della compagnia è il sig. Akira Morinaga.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web di Toshiba Electronics Europe all'indirizzo www.toshiba.semicon-storage.com.

Indirizzo di riferimento da pubblicare:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany

Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197

Web: www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

E-mail: discrete-ic@toshiba-components.com

Contatto per i giornalisti:

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tel: +44 (0)193 282 2832

E-mail: MShrimpton@teu.toshiba.de

Comunicato emesso da:

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +44 (0) 20 8429 6554

Web: www.publitek.com

E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com

Febbraio 2018

Rif.: 7115/A